イオン液体/ルブレン単結晶電気化学界面の局所構造解析

Local Structure Analyses of Electrochemical Interface between Ionic Liquid and Rubrene Single Crystal

阪大院基礎工¹, 阪大産研²

^O原 援又¹, 今西 哲士¹, 横田 泰之¹, 植村 隆文², 竹谷 純一², 福井 賢一¹

Grad. School of Engineer. Sci., Osaka Univ.¹, ISIR, Osaka Univ.²

[°]H. Hara¹, A. Imanishi¹, Y. Yokota¹, T. Uemura², J. Takeya², K. Fukui¹

E-mail: hara@surf.chem.es.osaka-u.ac.jp

ルブレン単結晶半導体とイオン液体を利 用した有機電界効果トランジスタ(OFET)は、 界面での電気二重層形成によってホールを 誘起させることで高い動作性能をもち^[1]、こ の界面構造と FET 性能の関係をより詳しく 理解することにより更なる性能向上が期待 される。特に、通常仮定されている理想的な 電気二重層の描像の検証が、この界面の微視 的理解を一歩進めることが重要となる。そこ で本研究では、周波数変調原子間力顕微鏡 (FM-AFM)を用いてイオン液体/ルブレン単 結晶界面の局所構造解析を行った。更に、実 際のトランジスタ動作環境下における電気 二重層界面について知見を得るため、電気化 学 FM-AFM を用いて界面状態の印加電圧依 存性を検討した。

FM-AFM を用いて、大気中観察ではほと んどステップが観察されない極めて平坦な ルブレン単結晶(001)面を、典型的なイオン 液体である BMIM-TFSI 中で観察した。する と、広領域でルブレン1 層分に対応するステ ップ構造が多数観察され、表面構造が不均一 になることが見出された(Fig. 1(a))。更に同 一領域の連続観察によって、これがルブレン の欠陥から面に沿って進行するルブレンの イオン液体中への溶出に因ることがわかっ た(Fig. 1(b)、(c))。また、探針を基板方向に 接近させた時の共振周波数の距離に対する 変化(フォースカーブ)を測定すると、

Figure 1 FM-AFM topographic images of rubrene(001) obtained in BMIM-TFSI. (a) $3 \times 3 \mu m^2$, $A_{p-p} = 1.37$ nm, $\Delta f = +100$ Hz. (b),(c) 16×16 nm², $A_{p-p} = 0.76$ nm, $\Delta f = +80$ Hz.





BMIM-TFSI のイオンペアの大きさに対応す

るピーク間隔の振動力が観察された(Fig. 2)。この結果から、ルブレン表面上にはイオン液体から なる溶媒和層が形成されていることが明らかとなった。また、EC-FM-AFM 観察によって、先述 のルブレン溶出の速度や溶媒和構造が印加電圧依存性を示すことがわかっており、当日はこれら の結果も合わせて詳しく議論する。

参考文献

[1] S. Ono, S. Seki, R. Hirahara, Y. Tominari, and J. Takeya, *Appl. Phys. Lett.* 92, 103313 (2008).
[2] Y. Yokota, T. Harada, and K. Fukui, *Chem. Commun.*, 46, 8627 (2010).